

ડાયોડના ફોરવડ્ડ અને રિવર્સ બાયસ (4311102) - વિન્ટર 2023 સોલ્યુશન

Milav Dabgar

જાન્યુઆરી 24, 2023

પ્રશ્ન 1(અ) [3 ગુણ]

ડાયોડના ફોરવડ્ડ અને રિવર્સ બાયસને વ્યાખ્યાયિત કરો.

જવાબ

જવાબ:

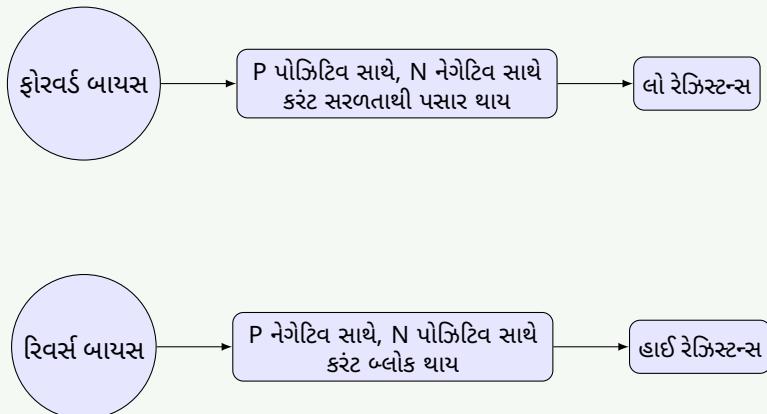
ડાયોડના ફોરવડ્ડ બાયસ:

- જોડાણની પદ્ધતિ: P-ટાઈપ બેટરીના પોઝિટિવ ટર્મિનલ સાથે અને N-ટાઈપ નેગેટિવ ટર્મિનલ સાથે જોડાયેલા હોય છે.
- અવરોધ પહોળાઈ: અવરોધની પહોળાઈ (Barrier width) ઘટે છે.
- અવરોધ: ઓછો અવરોધ (આશરે 100-1000 Ω).
- કરંટ પ્રવાહ: ડાયોડ દ્વારા સરળતાથી કરંટ પસાર થવા દે છે.

ડાયોડનો રિવર્સ બાયસ:

- જોડાણની પદ્ધતિ: P-ટાઈપ નેગેટિવ ટર્મિનલ સાથે અને N-ટાઈપ પોઝિટિવ ટર્મિનલ સાથે જોડાયેલા હોય છે.
- અવરોધ પહોળાઈ: અવરોધની પહોળાઈ (Barrier width) વધે છે.
- અવરોધ: ખૂબ ઊચો અવરોધ (આશરે કેટલાક M Ω).
- કરંટ પ્રવાહ: કરંટ પ્રવાહને અટકાવે છે (માત્ર નાનો લીકેજ કરંટ પસાર થાય છે).

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 1. ફોરવડ્ડ અને રિવર્સ બાયસ

મેમરી ટ્રીક

"`PFNR: "Positive to P Forward, Negative to P Reverse""`

પ્રશ્ન 1(બ) [4 ગુણ]

LDRનું બંધારણ અને કાર્ય સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

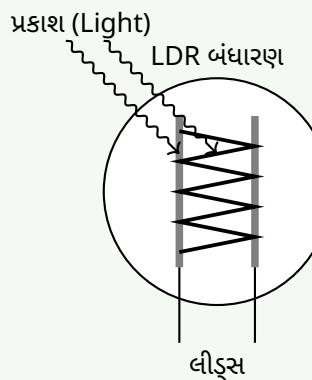
LDRનું બંધારણ:

- સામગ્રી: સેમિકર્કટર સામગ્રી (કેડમિયમ સલ્ફાઇડ - Cadmium Sulfide)થી બનેલું હોય છે.
- પેટર્ન: સિરામિક બેઝ પર ફોટોસેન્સિટિવ સામગ્રીનું જિગજેગ પેટર્ન હોય છે.
- ઇલેક્ટ્રોડ્સ: બંને છેડ મેટલ ઇલેક્ટ્રોડ્સ હોય છે.
- પેકેજિંગ: પારદર્શક પ્લાસ્ટિક અથવા ગલાસ કેસમાં એન્કેપ્સ્યુલેટેડ હોય છે.

કાર્યપ્રણાલી:

- સિલ્ફાંત: ફોટોકન્ડક્ટિવિટી (Photoconductivity) સિલ્ફાંત પર આધારિત છે.
- અંધકારમાં અવરોધ: અંધકારની સ્થિતિમાં ઉચ્ચ અવરોધ ($M\Omega$ રેન્જ) હોય છે.
- પ્રકાશ સંપર્ક: જ્યારે પ્રકાશના સંપર્કમાં આવે છે, ત્યારે ફોટોન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સને મુક્ત કરે છે.
- અવરોધમાં ઘટાડો: તેજ પ્રકાશમાં અવરોધ ઘટે છે ($k\Omega$ રેન્જ).

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 2. LDR બંધારણ

મેમરી ટ્રીક

“MILD: "More Illumination, Less Dark-resistance””

પ્રશ્ન 1(ક) [૭ ગુણ]

રેસિસ્ટરની કલર બેન્ડ કોર્ડિંગ પદ્ધતિ સમજવો. $47k\Omega \pm 5\%$ રેસિસ્ટરની કલર બેન્ડ લખો.

જવાબ

જવાબ:

કલર બેન્ડ કોર્ડિંગ પદ્ધતિ:

કોષ્ટક 1. રેસિસ્ટર કલર કોડ

રંગ	મૂલ્ય	ગુણાંક (Multiplier)	ટોલરન્સ
કાળો (Black)	0	10^0	-
ભ્રાઉન (Brown)	1	10^1	$\pm 1\%$
લાલ (Red)	2	10^2	$\pm 2\%$
નારંગી (Orange)	3	10^3	-
પીળો (Yellow)	4	10^4	-
લીલો (Green)	5	10^5	$\pm 0.5\%$
બ્રૂન (Blue)	6	10^6	$\pm 0.25\%$
વાયોલેટ (Violet)	7	10^7	$\pm 0.1\%$
ગ્રે (Grey)	8	10^8	$\pm 0.05\%$
સફેદ (White)	9	10^9	-
ગોલ્ડ (Gold)	-	10^{-1}	$\pm 5\%$
સિલ્વર (Silver)	-	10^{-2}	$\pm 10\%$
રંગવિહીન (Colorless)	-	-	$\pm 20\%$

4-બેન્ડ રેસિસ્ટર કલર કોડ:

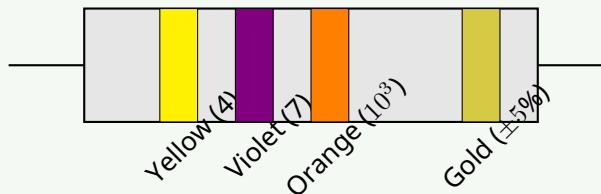
- પ્રથમ બેન્ડ: પ્રથમ અર્થપૂર્ણ અંક (First significant digit).
- બીજું બેન્ડ: બીજો અર્થપૂર્ણ અંક (Second significant digit).
- તૃજી બેન્ડ: ગુણાંક (Multiplier).
- ચોથી બેન્ડ: ટોલરન્સ (Tolerance).

47kΩ ±5% માટે:

- પ્રથમ અંક: 4 = પીળો (Yellow)
- બીજો અંક: 7 = વાયોલેટ (Violet)
- ગુણાંક: 10^3 = નારંગી (Orange) (for kΩ)
- ટોલરન્સ: ±5% = ગોલ્ડ (Gold)

47kΩ ±5% માટે કલર બેન્ડ: પીળો-વાયોલેટ-નારંગી-ગોલ્ડ (Yellow-Violet-Orange-Gold)

ડાયાગ્રામ:



આફ્ટર 3. રેસિસ્ટર કલર બેન્ડ્સ

મેમરી ટ્રીક

"BAND: "Beginning digits, Amplify with Multiplier, Note tolerance with last band, Decode carefully""

પ્રશ્ન 1(ક) OR [7 ગુણ]

એલ્યુમિનિયમ ઇલેક્ટ્રોલિટિક વેટ ટાઇપ કેપેસિટર સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

એલ્યુમિનિયમ ઇલેક્ટ્રોલિટિક વેટ ટાઇપ કેપેસિટર:

બંધારણ:

- જ્વાબસ: બે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ્સ (અનોડ અને કેથોડ).

- ડાયલેક્ટ્રિક: એનોડ ફોઇલ પર એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ લેયર.
- ઇલેક્ટ્રોલાઇટ: લિકિવિડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ (બોરિક એસિડ, સોડિયમ બોરિટ વગેરે).
- સેપ્ટેટર: ઇલેક્ટ્રોલાઇટમાં પ્લાનેલ પેપર સેપ્ટેટર.
- એન્ક્લોજર: રબર સીલ સાથેનું એલ્યુમિનિયમ કેન.

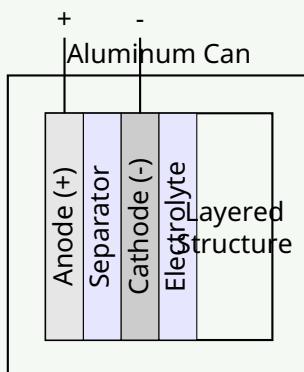
કાર્યપ્રણાલી:

- ઓક્સાઇડ લેયર: પાતળી એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ લેયર ડાયલેક્ટ્રિક તરીકે કામ કરે છે.
- ઇલેક્ટ્રોલાઇટ: બીજું પ્લેટ સાથે કેથોડ કનેક્શન તરીકે કાર્ય કરે છે.
- પોલરાઇઝેશન: નિર્ધારિત ધૂવીયતા (+ અને -) ટર્મિનલ્સ ધરાવે છે.

લાક્ષણિકતાઓ:

- ક્રેપેસીટન્સ રેન્જ: $1\text{ }\mu\text{F}$ થી $47,000\text{ }\mu\text{F}$
- વોલ્ટેજ રેટીંગ: 6.3V થી 450V
- પોલરાઇઝેશન: પોલરાઇડ (સાચું કનેક્શન જરૂરી છે)

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 4. એલ્યુમિનિયમ ઇલેક્ટ્રોલિટિક ક્રેપેસિટર

મેરી ટ્રીક

"POLE: "Polarized, Oxide layer, Liquid electrolyte, Enormous capacitance""

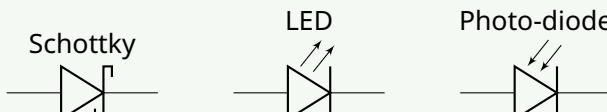
પ્રશ્ન 2(અ) [3 ગુણ]

શોટકી ડાયોડ, LED અને ફોટો-ડાયોડના સંજા દોરો.

જવાબ

જવાબ:

સંજાઓ:



આકૃતિ 5. ડાયોડ સંજાઓ

મુખ્ય લક્ષણો:

- શોટકી ડાયોડ (Schottky Diode): સ્ટાન્ડર્ડ ડાયોડ સંજા સાથે વધુ બાર (જે મેટલ-સેમિક્રિક્ટર જંક્શન દર્શાવે છે).
- LED: સ્ટાન્ડર્ડ ડાયોડ સંજા સાથે બહાર તરફ પોઈન્ટ કરતા બે તીર (જે પ્રકારા ઉત્સર્જન દર્શાવે છે).
- ફોટો-ડાયોડ (Photo-diode): સ્ટાન્ડર્ડ ડાયોડ સંજા સાથે ડાયોડ તરફ પોઈન્ટ કરતા બે તીર (જે પ્રકારા શોધણ દર્શાવે છે).

મેમરી ટ્રીક

“SLP: "Schottky has curve, LED emits, Photo-diode absorbs””

પ્રશ્ન 2(બ) [4 ગુણ]

ઉદાહરણ સાથે એક્ટિવ અને પેસીવ કમ્પોનન્ટ્સને વ્યાખ્યાયિત કરો.

જવાબ

જવાબ:

પેસીવ કમ્પોનન્ટ્સ (Passive Components):

કોષ્ટક 2. પેસીવ કમ્પોનન્ટ્સ

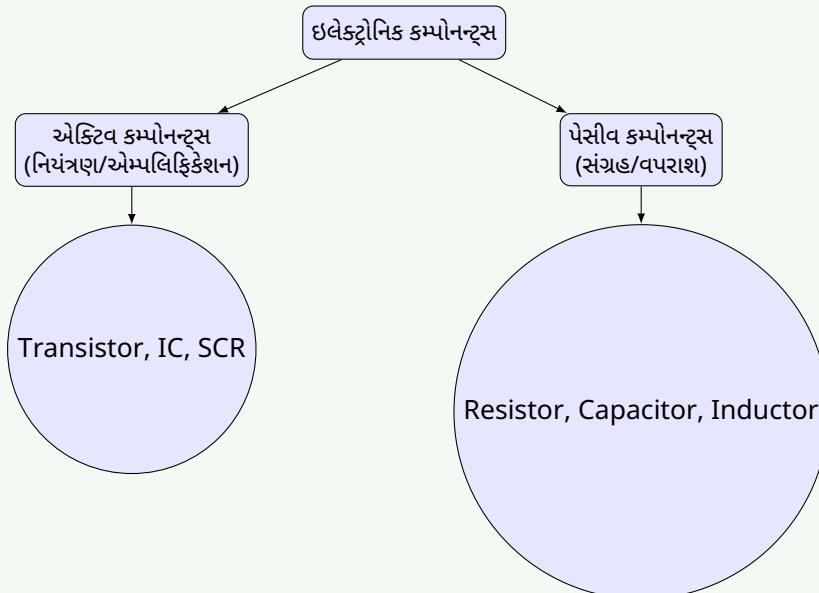
લાક્ષણિકતા	વર્ણન	ઉદાહરણો
પાવર	પાવર જનરેટ કરી શકતા નથી	રેસિસ્ટર્સ, કેપેસિટર્સ, ઇન્ડક્ટર્સ
સિગ્નલ	સિગ્નલને એમ્પલિફિય કરી શકતા નથી	ટ્રાન્સફોર્મર્સ, ડાયોડ્સ
શેર (Control)	કરંટ પ્રવાહ પર કોઈ નિયંત્રણ નથી	કનેક્ટર્સ, સ્લિવચેસ
ઓર્જા	ઓર્જા સંગ્રહ અથવા વપરાશ કરે છે	ફ્યુઝ, ફિલ્ટર્સ

એક્ટિવ કમ્પોનન્ટ્સ (Active Components):

કોષ્ટક 3. એક્ટિવ કમ્પોનન્ટ્સ

લાક્ષણિકતા	વર્ણન	ઉદાહરણો
પાવર	પાવર જનરેટ કરી શકે છે	ટ્રાન્జિસ્ટર્સ, ICs
સિગ્નલ	સિગ્નલને એમ્પલિફિય કરી શકે છે	એમ્પલિફિયર્સ, Op-amps
નિયંત્રણ	કરંટ પ્રવાહને નિયંત્રિત કરે છે	SCRs, MOSFETs
નિર્ભરતા	બાહ્ય પાવરની જરૂર પડે છે	વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર્સ

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 6. કમ્પોનન્ટ્સનું વર્ગીકરણ

મેમરી ટ્રીક

“PASS-ACT: "Passive stores or dissipates, Active controls or amplifies""

પ્રશ્ન 2(ક) [7 ગુણ]

કુલ વેવ બ્રિજ રેકિટફાયરની કાર્યપદ્ધતી સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

કુલ વેવ બ્રિજ રેકિટફાયર:

સર્કિટ બંધારણ:

- ડાયોડ્સ: બ્રિજ કોન્ફિગરેશનમાં ગોઠવાયેલા ચાર ડાયોડ્સ (D1-D4).
- ઇનપુટ: ટ્રાન્સફોર્મર સેકન્ડરીથી AC સપ્લાય.
- આઉટપુટ: ફિલ્ટર કેપેસિટર સાથે લોડ રેસિસ્ટર પર પદ્સેટિંગ DC.

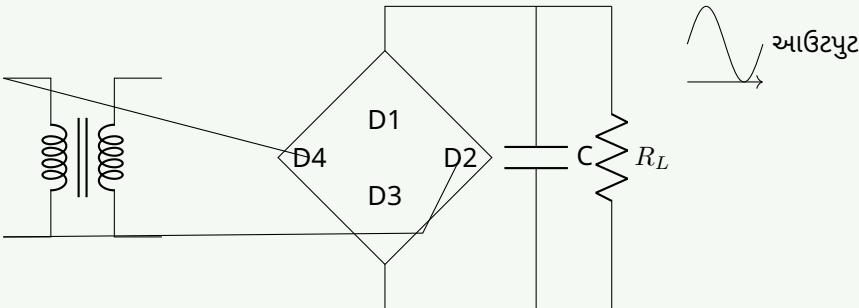
કાર્યપ્રણાલી:

- પોઝિટિવ હાફ સાયકલ: D1 અને D3 કન્ડક્ટ કરે છે, D2 અને D4 બ્લોક કરે છે. લોડ દ્વારા પ્રવાહ વહે છે.
- નેગેટિવ હાફ સાયકલ: D2 અને D4 કન્ડક્ટ કરે છે, D1 અને D3 બ્લોક કરે છે. લોડ દ્વારા સમાન દિશામાં પ્રવાહ વહે છે.

પેરામીટર:

- રિપલ ફિક્વન્સી: $2 \times$ ઇનપુટ ફિક્વન્સી.
- કાર્યક્ષમતા: 81.2%.
- PIV: V_m .

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 7. કુલ વેવ બ્રિજ રેકિટફાયર

મેમરી ટ્રીક

“BRIDGE: "Better Rectification with Improved Diode Geometry Efficiency""

પ્રશ્ન 2(અ OR) [3 ગુણ]

LED નું બંધારણ અને કાર્ય સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

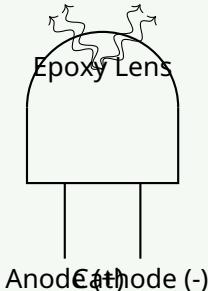
LED (Light Emitting Diode):

બંધારણ:

- સામગ્રી: સેમિકર્કટર (GaAs, GaP) P-N જંક્શન.
- પેક્જ: પારદર્શક એપોક્સી લેન્સ.
- લીડ્સ: એનોડ (લાંબો) અને કેથોડ (ઢૂકો).

કાર્યપ્રણાલી:

- બાયસ: ફોરવર્ડ બાયસ.
- સિદ્ધાંત: ઇલેક્ટ્રોન-હોલ રીકોમ્પ્લિનેશન દરમિયાન ફોટોન (પ્રકાશ) સ્વરૂપે ઊર્જા મુક્ત થાય છે.

ડાયાગ્રામ:

આકૃતિ 8. LED બંધારણ

મેમરી ટ્રીક

“LEDs: "Light Emits During electron-hole recombination in Semiconductor””

પ્રશ્ન 2(બ) OR [4 ગુણ]

કોમ્પોસીશન ટાઈપ રિસિસ્ટર સમજાવો.

જવાબ**જવાબ:**

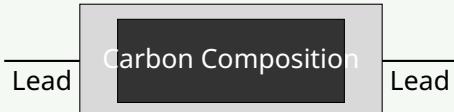
કોમ્પોસીશન રિસિસ્ટર્સ (Composition Resistors):

બંધારણ:

- કોર સામગ્રી: ઇન્સ્યુલેટિંગ સામગ્રી (માટી/સિરામિક) સાથે મિશ્ર કરેલા કાર્બન કણો.
- બાઈન્ડર: રેઝિન બાઈન્ડર જે નળાકાર આકાર આપે છે.
- રક્ષણા: ઇન્સ્યુલેટિંગ પેઇન્ટ અથવા પ્લાસ્ટિકનું કોર્ટિંગ.

લાક્ષણિકતાઓ:

- કિંમત: ઓછી કિંમત.
- અવાજ: ઉચ્ચ અવાજ (Noise).
- સ્થિરતા: ઓછી સ્થિરતા.

ડાયાગ્રામ:

આકૃતિ 9. કાર્બન કોમ્પોસીશન રિસિસ્ટર

મેમરી ટ્રીક

“CCRs: "Carbon Composition Resistors are Inexpensive””

પ્રશ્ન 2(ક) OR [7 ગુણ]

બે ડાયોડ - કુલ વેવ રેક્ટિફિયરની કાર્યપદ્ધતી સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

બે ડાયોડ કુલ વેવ રેકિટફાયર (સેન્ટર-ટેપ):

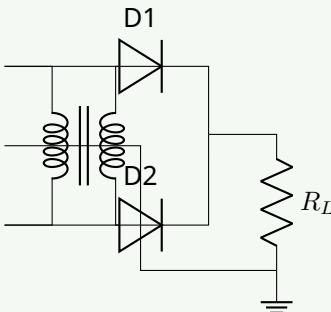
સર્કિટ બંધારણ:

- ટ્રાન્સફોર્મર: સેન્ટર-ટેપ સેકન્ડરી ટ્રાન્સફોર્મર.
- ડાયોડ્સ: બે ડાયોડ્સ (D1, D2).
- આઉટપુટ: સેન્ટર ટેપ અને કેથોડ જંક્શન વર્ચે.

કાર્યપ્રણાલી:

- પોઝિટિવ હાફ સાયકલ: D1 કન્ડક્ટ કરે છે, D2 બ્લોક કરે છે.
- નેગેટિવ હાફ સાયકલ: D2 કન્ડક્ટ કરે છે, D1 બ્લોક કરે છે.
- પરિણામ: લોડમાં હંમેશા એક જ દિશામાં કરંટ વહે છે.

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 10. સેન્ટર-ટેપ કુલ વેવ રેકિટફાયર

મેમરી ટ્રીક

“CTFWR: "Center Tap Facilitates Whole-cycle Rectification””

પ્રક્રિયા [3 ગુણ]

શોટકી ડાયોડની કાર્યપદ્ધતી સમજાવો.

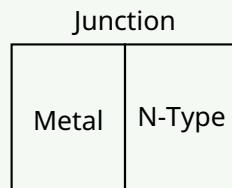
જવાબ

જવાબ:

શોટકી ડાયોડ:

- જંક્શન: મેટલ-સેમિક્ડક્ટર (Metal-Semiconductor) જંક્શન.
- કેરિયર: મેજોરિટી કેરિયર ડિવાઇસ (ઇલેક્ટ્રોનિક્સ).
- ફોરવર્ડ વોલટેજ: ખૂબ ઓછું (0.2-0.4V).
- સ્વિચિંગ: ખૂબ જડપી સ્વિચિંગ સ્પીડ (Fast switching).
- ઉપયોગ: હાઈ-ફિક્વન્સી એપ્લિકેશન્સ.

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 11. શોટકી ડાયોડ સ્ટ્રક્ચર

મેમરી ટ્રીક

``SFAM: "Schottky's Fast And Metal-based""

પ્રશ્ન 3(બ) [4 ગુણ]

N ટાઈપ સેમિકંડક્ટર સમજાવો.

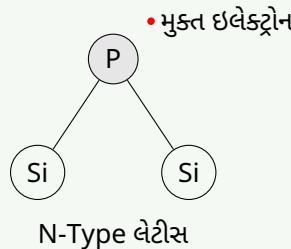
જવાબ

જવાબ:

N-ટાઈપ સેમિકંડક્ટર:

- ડોપિંગ: શુદ્ધ સિલિકોનમાં પેન્ટાવેલન્ટ (Pentavalent) અશુદ્ધિ (જેમ કે ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક) ઉમેરવામાં આવે છે.
- પરિણામ: દરેક અશુદ્ધિ પરમાળું એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન આપે છે.
- કેરિયર્સ: ઇલેક્ટ્રોન્સ (મેજોરિટી), હોલ્ડ્સ (માઇનોરિટી).
- ચાર્જ: એક્ષિંદરે તાત્ત્વ (Neutral) હોય છે.

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 12. N-Type ડોપિંગ

મેમરી ટ્રીક

``PENT: "Pentavalent Element makes N-Type with free electrons""

પ્રશ્ન 3(ક) [7 ગુણ]

PN જંક્શન ડાયોડનું બંધારણ અને કાર્ય સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

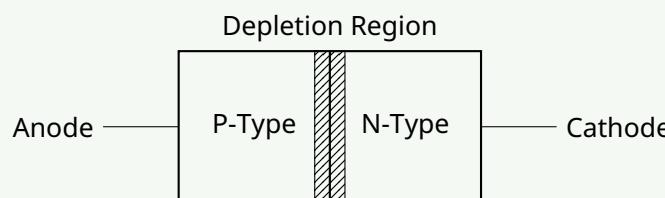
બંધારણ:

- P-ટાઈપ અને N-ટાઈપ સેમિકંડક્ટરના સંયોજનથી બને છે.
- જંક્શન પર ડિપ્લેશન લેયર (Depletion Layer) ર્યાય છે.

કાર્યપ્રણાલી:

- ફોર્વ્ઝ બાયસ: વોલ્ટેજ $>$ બેરિયર પોટેન્શિયલ ($0.7V$ for Si). ડિપ્લેશન રીજન સાંકડો થાય છે અને કર્ટ વહે છે.
- રિવર્સ બાયસ: ડિપ્લેશન રીજન પહોળો થાય છે. કર્ટ બ્લોક થાય છે (લીકેજ સિવાય).

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 13. PN જંકશન

મેમરી ટ્રીક

“BIRD: "Barrier forms at Interface, Rectifies Direct current""

પ્રશ્ન 3(અ) OR [3 ગુણ]

ફોટો ડાયોડની કાર્યપદ્ધતી સમજાવો.

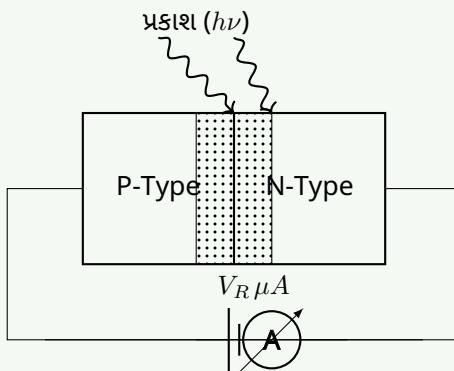
જવાબ

જવાબ:

કાર્યપદ્ધતિ:

- ઓપરેશન: હંમેશા રિવર્સ બાયસ (Reverse Bias) સ્થિતિમાં કાર્ય કરે છે.
- ડાર્ક કરેટ: જ્યારે પ્રકાશ ન હોય ત્યારે ખૂબ ઓછો પ્રવાહ (Dark Current) વહે છે.
- પ્રકાશ આપાત: જ્યારે જંકશન પર પ્રકાશ પડે છે, ત્યારે કોવેલેન્ટ બોન્ડ તૂટે છે.
- કેરિયર જનરેશન: ઇલેક્ટ્રોન-હોલ જોડી ઉત્પન્ન થાય છે.
- ફોટોકરેટ: રિવર્સ કરેટ પ્રકાશની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં વધે છે.

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 14. ફોટો ડાયોડ ઓપરેશન

મેમરી ટ્રીક

“DARK: "Dark current exists, Absorbs photons, Reverse bias, K-current increases""

પ્રશ્ન 3(બ) OR [4 ગુણ]

P ટાઇપ સેમિકિક્ટર સમજાવો.

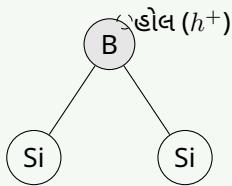
જવાબ

જવાબ:

P-ટાઇપ સેમિકિક્ટર:

- ડોપિંગ: શુદ્ધ સેમિકિક્ટરમાં ટ્રાઇવેલન્ટ (Trivalent) અશુદ્ધિ (જેમ કે બોરોન, એલ્યુમિનિયમ, ગોલિયમ) ઉમેરવામાં આવે છે.
- હોલ્સ: અશુદ્ધિ પરમાણુ હોલ્સ (Holes) ઉત્પન્ન કરે છે.
- કેરિયર્સ: હોલ્સ (મેઝોરિટી), ઇલેક્ટ્રોન્સ (માઇનોરિટી).
- ચાર્જ: એકંદરે તટસ્થ (Neutral) હોય છે.

ડાયાગ્રામ:



P-Type લેટીસ

આકૃતિ 15. P-Type ડોપિંગ

મેમરી ટ્રીક

"TRIP: "Trivalent Impurity produces Positive holes""

પ્રશ્ન 3(ક) OR [7 ગુણ]

હાફ વેવ અને કુલ વેવ રેન્ડિટ્ફાયરની સરખામણી કરો.

જવાબ

જવાબ:

કોષ્ટક 4. રેન્ડિટ્ફાયર સરખામણી

પેરામીટર	હાફ વેવ	સેન્ટર ટેપ	બ્રિજ
ડાયોડ સંખ્યા	1	2	4
મહત્તમ કાર્યક્ષમતા	40.6%	81.2%	81.2%
રિપલ ફેક્ટર	1.21	0.48	0.48
રિપલ ફિક્વાન્સી	f_{in}	$2f_{in}$	$2f_{in}$
PIV રેટિંગ	V_m	$2V_m$	V_m
TUF	0.287	0.693	0.812
આઉટપુટ વોલ્ટેજ	V_m/π	$2V_m/\pi$	$2V_m/\pi$
ટ્રાન્સફોર્મર	સાંકુ	સેન્ટર ટેપ	સાંકુ

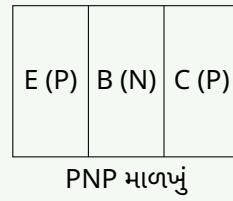
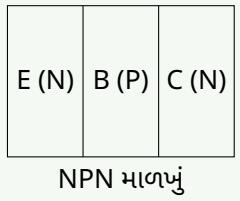
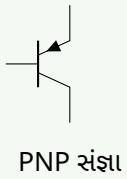
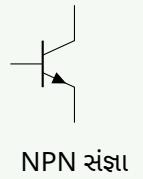
પ્રશ્ન 4(અ) [3 ગુણ]

PNP અને NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટરની સંજા અને બંધારણ ચોગ્ય નામ નિદેશ સાથે દોરો.

જવાબ

જવાબ:

બંધારણ અને સંજાઓ:



આકૃતિ 16. ટ્રાન્ઝિસ્ટર સંકાચ અને બંધારણ

મેમરી ટ્રીક

“P-POINT: “PNP Points In, NPN Points Out””

પ્રશ્ન 4(બ) [4 ગુણ]

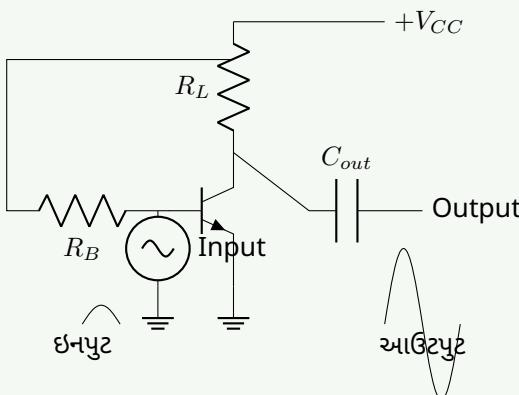
ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમલીફાયરની કાર્યપદ્ધતી સમજાવો.

જવાબ

કાર્યપદ્ધતિ:

- બાયસિંગ:** એમિટર-બેઝ જંકશન ફોરવર્ડ બાયસ, કલેક્ટર-બેઝ જંકશન રિવર્સ બાયસ (એક્ટિવ રીજન).
- ઇનપુટ:** બેઝ-એમિટર વચ્ચે નિર્બળ AC સિન્ઘલ આપવામાં આવે છે.
- નિયંત્રણ:** બેઝ કરંટ (I_B) માં નાના ફેરફારો કલેક્ટર કરંટ (I_C) માં મોટા ફેરફારો કરે છે.
- ગેઠન:** કરંટ ગેઠન β ઊચો હોય છે.
- આઉટપુટ:** લોડ રેસિસ્ટર પર એમલીફાઇડ વોલ્ટેજ મળે છે.

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 17. CE એમલીફાયર

પ્રશ્ન 4(ક) [7 ગુણ]

ઝનર ડાયોડની કાર્યપદ્ધતિ સમજાવો.

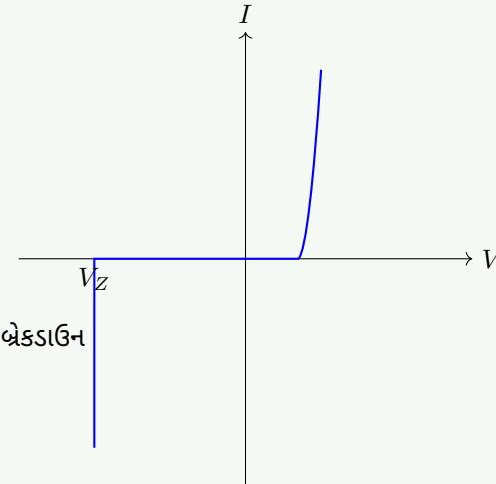
જવાબ

જવાબ:

ઝનર ડાયોડ:

- ઓપરેશન: રિવર્સ બ્રેકડાઉન રીજનમાં કાર્ય કરવા માટે રચાયેલ છે.
- ફોરવર્ડ બાયસ: સામાન્ય ડાયોડની જેમ કાર્ય કરે છે.
- રિવર્સ બાયસ: આમુક વોલ્ટેજ (V_Z) સૂધી કરંટ બ્લોક કરે છે.
- બ્રેકડાઉન: V_Z પર, કરંટમાં નીત્ર વધારો થાય છે (Zener Effect).
- વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન: કરંટમાં મોટા ફેરફાર છતાં વોલ્ટેજ અચળ રહે છે.
- ઉપયોગ: વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર તરીકે.

ક્રેકટરીસ્ટીક્સ:



આકૃતિ 18. ઝનર ડાયોડ ગ્રાફ

મેમરી ટ્રીક

“ZAP: “Zener Always Provides constant voltage””

પ્રશ્ન 4(અ OR) [3 ગુણ]

ટ્રાન્ઝિસ્ટરને સ્વીચ તરીકે સમજાવો.

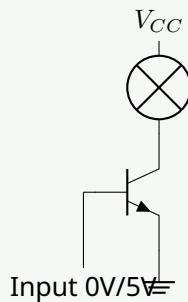
જવાબ

જવાબ:

ટ્રાન્ઝિસ્ટર સ્વીચ:

- OFF (કટાયોફ):**
 - બેઝ કરંટ $I_B = 0$.
 - કટ-ઓફ રીજન.
 - ઓપન સ્વિચ તરીકે વર્તો છે.
- ON (સેચ્યુરેશન):**
 - પૂરતો બેઝ કરંટ આપવામાં આવે છે.
 - સેચ્યુરેશન રીજન.
 - કલોડ સ્વિચ તરીકે વર્તો છે ($V_{CE} \approx 0.2V$).

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 19. ટ્રાન્ઝિસ્ટર સ્વીચ

મેમરી ટ્રીક

“CO-SI: “Cut-off is Open, Saturation is Closed””

પ્રશ્ન 4(બ) OR [4 ગુણ]

CE એમલીફાયરની કેરેક્ટરીસ્ટીક્સ દોરો અને સમજાવો.

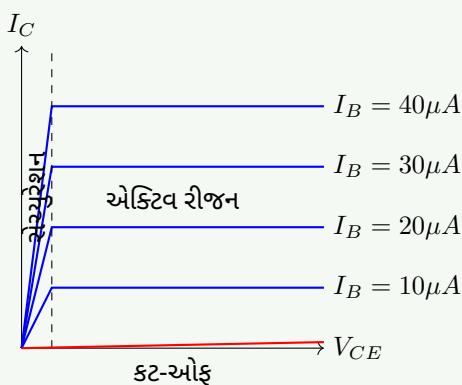
જવાબ

જવાબ:

લાક્ષણિકતાઓ:

- ઇનપુટ લાક્ષણિકતા: V_{BE} વિરાધ I_B . ફોરવર્ડ બાયસ ડાયોડ જેવી હોય છે.
- આઉટપુટ લાક્ષણિકતા: V_{CE} વિરાધ I_C (અથળ I_B પર).
 - કટ-અોફ: $I_B = 0$, ટ્રાન્ઝિસ્ટર OFF.
 - એક્ટિવ: ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમલીફાયર તરીકે કામ કરે છે.
 - સેચ્યુરેશન: ટ્રાન્ઝિસ્ટર સંપૂર્ણ ON હોય છે.

ડાયાગ્રામ:



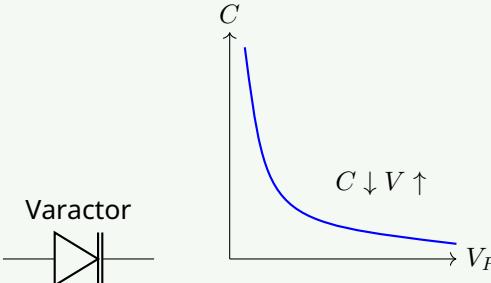
આકૃતિ 20. CE આઉટપુટ કેરેક્ટરીસ્ટીક્સ

પ્રશ્ન 4(ક) OR [7 ગુણ]

વરેક્ટર ડાયોડની કાર્યપદ્ધતિ સમજાવો.

જવાબ**જવાબ:****કાર્યપદ્ધતિ:**

- કાર્ય: વોલ્ટેજ દ્વારા નિયંત્રિત વેરિયેબલ કેપેસિટર (Variable Capacitor) તરીકે વર્તે છે.
- બાયસ: હમેશા રિવર્સ બાયસમાં.
- સિલ્ફાન્ડાંટ: રિવર્સ વોલ્ટેજ વધારતા ડિપ્લેશન લેયરની પહોળાઈ વધે છે, જેથી કેપેસીટન્સ ઘટે છે ($C \propto 1/\sqrt{V}$).
- ઉપયોગ: ટ્યુનિંગ સર્કિટ્સ (Radio/TV), VCOs.

ડાયાગ્રામ:

આકૃતિ 21. વેરેક્ટર ડાયોડ

મેમરી ટ્રીક

“VARY: "Voltage Adjusts Reverse-bias Yielding capacitance””

પ્રશ્ન 5(અ) [3 ગુણ]

ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમલીફાયર માટે એક્ટિવ, સેચ્યુરેશન અને કટ-ઓફ રીજીયનની વ્યાખ્યા આપો.

જવાબ**જવાબ:**

- એક્ટિવ (Active):** બેઝ-એમિટર જંકશન ફોરવર્ડ, કલેક્ટર-બેઝ રિવર્સ. (એમલીફાયર તરીકે વપરાય છે).
- સેચ્યુરેશન (Saturation):** બંને જંકશન ફોરવર્ડ બાયસ. (ON સ્વિચ તરીકે).
- કટ-ઓફ (Cut-off):** બંને જંકશન રિવર્સ બાયસ. (OFF સ્વિચ તરીકે).

પ્રશ્ન 5(બ) [4 ગુણ]

જો $I_C = 10mA$ અને $I_B = 100\mu A$ તો કર્ણ ગેઇન α , અને β ની કીમત શોધો.

જવાબ**જવાબ:**

આપેલ: $I_C = 10mA$, $I_B = 100\mu A = 0.1mA$.

ગણતરી:

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{I_C}{I_B} = \frac{10}{0.1} = 100 \\ I_E &= I_C + I_B = 10 + 0.1 = 10.1mA \\ \alpha &= \frac{I_C}{I_E} = \frac{10}{10.1} \approx 0.99\end{aligned}$$

પરિણામ: $\alpha = 0.99$, $\beta = 100$.

પ્રશ્ન 5(ક) [7 ગુણ]

નાના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગોમાં ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ મેનેજમેન્ટની વ્યૂહરચનાઓની ચર્ચા કરો.

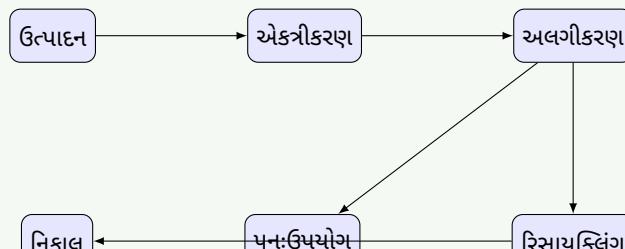
જવાબ

જવાબ:

વ્યૂહરચનાઓ (Strategies):

- ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ: સાધનોનું આયુષ્ય અને જરૂરિયાતનું યોગ્ય આયોજન.
- ઘટાડો (Reduce): બિનજરૂરી ખરીદી ટાળવી. મોડ્યુલર અપગ્રેડ્સ પરસંદ કરવા.
- પુનઃઉપયોગ (Reuse): જૂના સાધનોનો અન્ય કાર્યો માટે ફરીથી ઉપયોગ કરવો.
- રિસાયકલ (Recycle): અધિકૃત રિસાયકલર્સ સાથે ભાગીદારી કરવી.
- અલગીકરણ (Segregation): ઈ-વેસ્ટ માટે અલગ ડફ્બા રાખવા.
- કર્મચારી તાલીમ: યોગ્ય નિકાલ માટે કર્મચારીઓને જાગૃત કરવા.

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 22. ઈ-વેસ્ટ ફ્લો

મેમરી ટ્રીક

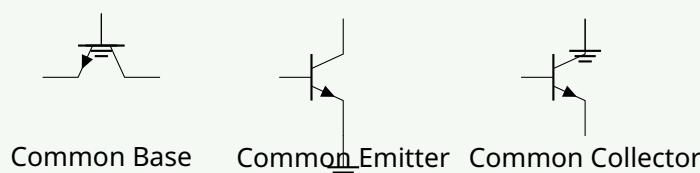
“3R: "Reduce, Reuse, Recycle""

પ્રશ્ન 5(અ) OR) [3 ગુણ]

CB, CE અને CC ટ્રાન્ઝિસ્ટરની સરકીટ રૂપરેખાંકન દોરો.

જવાબ

જવાબ:



આકૃતિ 23. ટ્રાન્ઝિસ્ટર રૂપરેખાંકનો

પ્રશ્ન 5(બ) OR) [4 ગુણ]

કરંટ ગેઈન α અને β વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો.

જવાબ

જવાબ:

તારવણી:

- ટ્રાન્ઝિસ્ટર કરંટ સમીકરણ:

$$I_E = I_C + I_B$$

- I_C વડે ભાગતા:

$$\frac{I_E}{I_C} = 1 + \frac{I_B}{I_C} \Rightarrow \frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{\beta}$$

- α માટે ઉકેલતા:

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

- β માટે ઉકેલતા:

$$\frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha} - 1 = \frac{1 - \alpha}{\alpha} \Rightarrow \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

પ્રશ્ન 5(ક) OR [7 ગુણ]

ઈ-વેસ્ટની વ્યાખ્યા કરો અને ઈલેક્ટ્રોનિક કચરાનો નિકાલ સમજાવો.

જવાબ

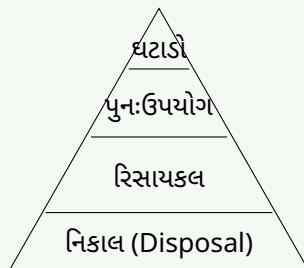
જવાબ:

ઈ-વેસ્ટ (E-Waste): બિનઉપયોગી અથવા નકામા થઈ ગયેલા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો (જેમ કે કોમ્પ્યુટર, મોબાઇલ, પ્રિન્ટર).

નિકાલ પદ્ધતિઓ:

- રિસાયકલિંગ (Recycling): સૌથી શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ. કિમતી ધાતુઓની પુનઃપ્રાપ્તિ અને પ્લાસ્ટિકનો પુનઃઉપયોગ.
- ઇન્સિનરેશન (Incineration): નિયંત્રિત તાપમાને સળગાવવંનું, કચરાનું પ્રમાણ ઘટાડે છે પરંતુ વાયુ પ્રદૂષણ કરી શકે છે.
- લેન્ડફિલ (Landfilling): જમીનમાં દાટવું. સૌથી ઓછી પસંદગીની પદ્ધતિ કારણ કે ઊરી તત્ત્વો જમીનમાં ઉત્તરે છે.
- પુનઃઉપયોગ (Reuse): સમારકામ કરીને ફરી વાપરવું.
- એસિડ બાથ: ધાતુઓ મેળવવા એસિડનો ઉપયોગ (ખતરનાક પદ્ધતિ).

ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 24. વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પિરામિદ